

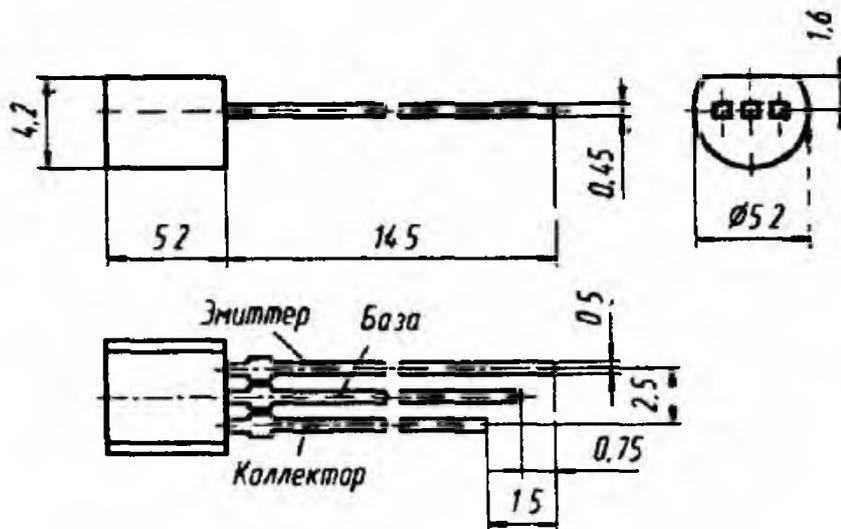
## КТ350А

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *p-n-p* универсальный. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты и переключающих устройствах. Выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. На корпусе наносится условная маркировка двумя точками серого и розового цвета.

Масса транзистора не более 0,3 г.

Изготовитель — завод полупроводниковых приборов, г. Рига.

### КТ350А



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{КБ} = 1$  В,  $I_3 = 500$  мА:

$T = +25$ °С .....	20...70*...200
$T = -40$ °С .....	0,5 значения при $T = +25$ °С
$T = +85$ °С .....	От 0,9 до 2 значений при $T = +25$ °С

Граничная частота коэффициента передачи

тока при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 10$ мА, не менее .....	100 МГц
типичное значение .....	280* МГц

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер

при $I_К = 500$ мА, $I_Б = 50$ мА, не более .....	1 В
типичное значение .....	0,19* В

Напряжение насыщения база—эмиттер

при $I_К = 500$ мА, $I_Б = 50$ мА, не более .....	1,25 В
типичное значение .....	0,92* В

Обратный ток коллектора при  $U_{КБ} = 10$  В, не более:

$T = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$ .....	1 мкА
$T = +85\text{ }^{\circ}\text{C}$ .....	15 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{зб} = 4\text{ В}$ , не более .....	10 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 5\text{ В}$ , не более .....	70 пФ
типичное значение .....	12* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{зб} = 1\text{ В}$ , не более .....	100 пФ
типичное значение .....	68* пФ

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база .....	20 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{бз} \leq 10\text{ кОм}$ .....	15 В
Постоянное напряжение эмиттер—база .....	5 В
Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 1\text{ мкс}$ , $Q \geq 10$ .....	600 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора <sup>1</sup> :	
при $T \leq +30\text{ }^{\circ}\text{C}$ .....	300 мВт
при $T = +85\text{ }^{\circ}\text{C}$ .....	162,5 мВт
Тепловое сопротивление переход—среда .....	0,4 $^{\circ}\text{C}/\text{мВт}$
Температура $p$ - $n$ перехода .....	+150 $^{\circ}\text{C}$
Температура окружающей среды .....	-40...+85 $^{\circ}\text{C}$

<sup>1</sup> В диапазоне температур +30...+85  $^{\circ}\text{C}$  допустимое значение рассеиваемой мощности снижается линейно.

Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм.

Минимально допустимое расстояние от места пайки выводов до корпуса 5 мм при температуре не выше +250  $^{\circ}\text{C}$  и длительности не более 10 с. Температура корпуса при пайке не должна превышать +150  $^{\circ}\text{C}$ .